

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-217342
(43)Date of publication of application : 31.07.2003

(51)Int.Cl. H01B 1/06
C08G 65/40
C08G 75/23
H01B 13/00
H01M 8/02
H01M 8/10

(21)Application number : 2002-015986
(22)Date of filing : 24.01.2002

(71)Applicant : TOYOBO CO LTD
(72)Inventor : KITAMURA KOTA
TAKASE SATOSHI
SAKAGUCHI YOSHIMITSU
NAGAHARA SHIGENORI
HAMAMOTO SHIRO
NAKAO JUNKO

(54) PHOTO-CROSSLINKABLE POLYMER SOLID ELECTROLYTE, CROSSLINKED POLYMER SOLID ELECTROLYTE FILM AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polymer solid electrolyte film and a manufacturing method therefor in which not only excellent ion conductivity is exhibited but also durability such as a swelling-resistant property is simultaneously excellent and it can be preferably used for a proton exchange film of a fuel cell or the like.

SOLUTION: After a photo-crosslinkable polymer electrolyte having one or more ionic group and photo-crosslinkable group in the molecule respectively is molded into a film, the thermal crosslinkable group is subjected to crosslinking reaction by irradiation with light to obtain the polymer solid electrolyte film. The crosslinking reaction can be carried out without accompanying decomposition of the ionic group and the ion conductivity is not reduced by the crosslinking reaction. The polymer solid electrolyte film having excellent ion conductivity and durability can be obtained.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-217342

(P2003-217342A)

(43) 公開日 平成15年7月31日 (2003.7.31)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	マークコード ⁸ (参考)
H 01 B 1/06		H 01 B 1/06	A 4 J 0 0 5
C 08 G 65/40		C 08 G 65/40	4 J 0 3 0
	'5/23	75/23	5 G 3 0 1
H 01 B 13/00		H 01 B 13/00	Z 5 H 0 2 6
H 01 M 8/02		H 01 M 8/02	P
		審査請求 未請求 請求項の数 8	OL (全 8 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-15986(P2002-15986)

(22) 出願日 平成14年1月24日 (2002.1.24)

(71) 出願人 000003160

東洋紡績株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

(72) 発明者 北村 幸太

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

(72) 発明者 高瀬 敏

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

(72) 発明者 坂口 佳充

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光架橋性高分子固体電解質、架橋高分子固体電解質膜及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 優れたイオン伝導性を示すだけでなく、同時に耐膨潤性などの耐久性にも優れ、燃料電池などのプロトン交換膜にも好適に使用することができる高分子固体電解質膜及びその製造方法の提供。

【解決手段】 分子中に、イオン性基と、光架橋性基とをそれぞれ1個以上有している光架橋性高分子電解質を、膜に成形した後に、光照射によって熱架橋性基を架橋反応させて、高分子固体電解質膜を得る。イオン性基の分解を伴わずに架橋反応させることができ、また架橋反応によるイオン伝導性の低下もなく、イオン伝導性と耐久性に優れた高分子固体電解質膜を得ることができる。

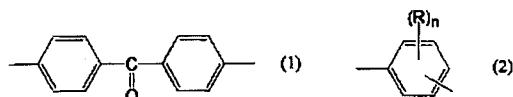
【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子中にイオン性基と、光架橋性基とをそれぞれ1個以上有していることを特徴とする高分子固体電解質。

【請求項2】 イオン性基がスルホン酸基又はホスホン酸基であることを特徴とする請求項1に記載の高分子固体電解質。

【請求項3】 光架橋性基として下記一般式(1)及び(2)で表される基を有することを特徴とする請求項1乃至2のいずれかに記載のポリマー電解質。

【化1】



(式中、Rは炭素数1～10の脂肪族炭化水素基を、nは1～4の整数を表す。)

【請求項4】 ポリマー主鎖がポリエーテルスルホン又はポリエーテルケトンであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の高分子固体電解質。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の高分子固体電解質を単独又は一成分として含むポリマー組成物を架橋して得ることを特徴とする高分子固体電解質。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれかに記載の高分子固体電解質を単独又は一成分として含むポリマー組成物から形成された膜を光照射して架橋高分子固体電解質膜を得ることを特徴とする高分子固体電解質膜の製造方法。

【請求項7】 請求項6に記載の方法で製造された高分子固体電解質膜。

【請求項8】 請求項1乃至7のいずれかに記載の高分子固体電解質を用いた燃料電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、耐久性及びイオン伝導性に優れた光架橋性高分子固体電解質、高分子固体電解質膜及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】液体電解質のかわりに高分子固体電解質をイオン伝導体として用いる電気化学的装置の例として、水電解槽や燃料電池を挙げることができる。これらに用いられる高分子膜は、カチオン交換膜として高いプロトン伝導率を有すると共に化学的、熱的、電気化学的及び力学的に十分安定なものでなくてはならない。このため、長期にわたり使用できるものとして、主に米デュポン社製の「ナフィオン（登録商標）」を代表例とするパーカーフルオロカーボンスルホン酸膜が使用されてきた。しかしながら、100°Cを超える条件で運転しようとすると、膜の含水率が急激に落ちる他、膜の軟化も顕著となる。このため、メタノールを燃料とする燃料電池においては、膜内のメタノール透過による性能低下が起こ

り、十分な性能を発揮することはできない。また、現在主に検討されている水素を燃料として80°C付近で運転する燃料電池においても、膜のコストが高すぎる事が燃料電池技術の確立の障害として指摘されている。

【0003】パーカーフルオロカーボンスルホン酸膜に代わる電解質膜として、ポリエーテルエーテルケトンやポリエーテルスルホン、ポリスルホンなどのポリマーにスルホン酸基などイオン性基を導入した、いわゆる炭化水素系高分子固体電解質が近年盛んに検討されている。しかしながら、炭化水素系高分子固体電解質はパーカーフルオロカーボンスルホン酸に比べて水和・膨潤しやすく、高温度下での耐久性に問題があった。

【0004】膨潤を抑制する方策の一つとして、塩基性ポリマーとの混合が行なわれている。これは、高分子固体電解質中のスルホン酸基を、塩基性ポリマーによって架橋することで膨潤を抑制しようとするものである。例えば、スルホン酸基を有するポリエーテルスルホンやスルホン酸基を有するポリエーテルエーテルケトン（酸性ポリマー）と、ポリベンゼンイミダゾール（塩基性ポリマー）との混合物（国際公開特許公報WO99/54389号公報）などが知られている。

【0005】また、特開平6-93114号公報、国際公開特許WO99/61141号公報、特開2001-522401号公報に記載されているように、イオン性基であるスルホン酸基間を共有結合により架橋することで、膨潤を抑制することも行なわれている。

【0006】上記の方法はいずれも膨潤は抑制できるものの、イオン性基が架橋反応によりイオン性を示さなくなるため、イオン伝導性が低下するという問題点があった。

【0007】架橋構造を有する高分子固体電解質としてスチレン/ジビニルベンゼン共重合体のスルホン化物は、初期の固体高分子形燃料電池に使用されたことで良く知られている。この高分子固体電解質は、ポリマー骨格そのものの耐久性に乏しく燃料電池として満足な性質を示さなかった。特開平2-248434号公報、特開平2-245035号公報には、ルイス酸を触媒としてポリマー中のクロロメチル基を架橋反応させて得られるイオン交換体が記載されている。しかしながら架橋反応に触媒が必要である。よって、ポリマーと触媒を混合して成形体を得る場合には触媒の残留が、ポリマー成形体を触媒で処理する場合には内部で架橋反応が起こりにくいことが、それぞれ問題であった。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、燃料電池などのプロトン交換膜に好適な、イオン伝導性及び耐久性に優れた、光架橋性高分子固体電解質、高分子固体電解質膜及びその製造方法を提供することである。

【0009】

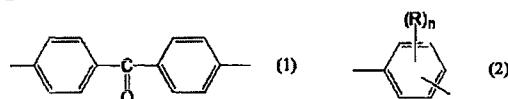
【課題を解決するための手段】本発明者らは、銳意研究

を重ねた結果、光架橋性基とイオン性基を有する高分子固体電解質を用いることで上記目的を達成できることを見出した。

【0010】すなわち本発明は、(1) 分子中にイオン性基と、光架橋性基とをそれぞれ1個以上有していることを特徴とする高分子固体電解質、(2) イオン性基がスルホン酸基又はホスホン酸基であることを特徴とする(1)に記載の高分子固体電解質、(3) 光架橋性基として下記一般式(1)及び(2)で表される基を有することを特徴とする(1)又は(2)のいずれかに記載のポリマー電解質、

【0011】

【化2】



(式中、Rは炭素数1～10の脂肪族炭化水素基を、nは1～4の整数を表す。)

(4) ポリマー主鎖がポリエーテルスルホン又はポリエーテルケトンであることを特徴とする(1)～(3)のいずれかに記載の高分子固体電解質、(5) (1)～(4)のいずれかに記載の高分子固体電解質を単独又は一成分として含むポリマー組成物を架橋して得ることを特徴とする高分子固体電解質、(6) (1)～(4)のいずれかに記載の高分子固体電解質を単独又は一成分として含むポリマー組成物から形成された膜を光照射して架橋高分子固体電解質を得ることを特徴とす

る高分子固体電解質膜の製造方法、(7) (6)に記載の方法で製造された高分子固体電解質膜、(8) (1)～(7)のいずれかに記載の高分子固体電解質を用いた燃料電池、である。

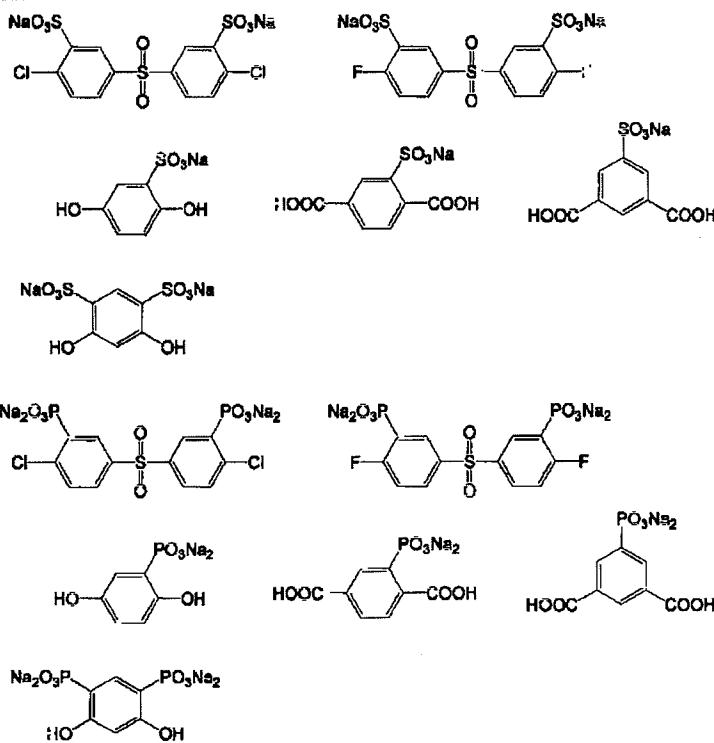
【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明する。本発明における光架橋性高分子固体電解質は、ポリマー分子中に少なくとも1個以上の光架橋性基及びイオン性基を有していることが必要である。ポリマーの数平均分子量は1,000～1,000,000の間であることが好ましく、5,000～500,000の間であることが物性と加工性のバランスが取れるため好ましい。

【0013】イオン性基はスルホン酸基、ホスホン酸基、リン酸基、カルボン酸基などのイオンに解離することのできる基を表す。より好ましくはスルホン酸基又はホスホン酸基である。スルホン酸基はイオン伝導性が高く、ホスホン酸基は高温でもイオン伝導性を示すため、それぞれ好ましい。ポリマー中のイオン性基の量は、0.1～5.0mmol/gであることが好ましく、1.0～3.0mmol/gであることがより好ましい。ポリマー中には、イオン性基を有するモノマーの共重合やポリマーのスルホン化反応によってイオン性基を導入することができる。イオン性基を有するモノマーとしては、下記に示すような化合物が挙げられる。

【0014】

【化3】



また、無水硫酸、無水硫酸の錯体、発煙硫酸、濃硫酸、クロロスルホン酸などのスルホン化剤を用いてポリマー

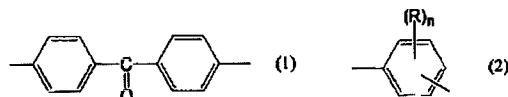
にスルホン酸基を導入することもできる。ポリマーをスルホン化剤に対して不活性な溶媒に溶解した状態でスル

ホン化剤を反応させる方法や、ポリマーを適当な溶媒で膨潤させた状態でスルホン化剤を反応させる方法、ポリマーを直接スルホン化剤と反応させる方法、などの方法によってスルホン化反応を行なうことができる。スルホン化剤はそのまま用いてもよいし、適当な溶媒に溶解、分散した状態で用いることもできる。反応温度は-100~100°Cの間で行なうことができる。

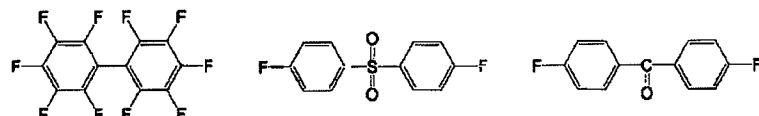
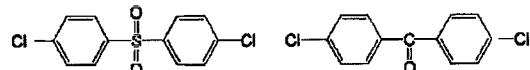
【0015】光架橋性基としては、ベンゾフェノン基、 α -ジケトン基、アシロイン基、アシロインエーテル基、ベンジルアルキルケタール基、アセトフェノン基、多核キノン類、チオキサントン基、アシルfosfin基、エチレン性不飽和基などを挙げることができる。中でもベンゾフェノン機などの光によりラジカルを発生することのできる基と、メチル基やエチル基などの炭化水素基を有する芳香族基などの、ラジカルと反応することのできる基との組み合わせが好ましく、例として下記のような基を挙げることができる。

【0016】

【化4】



これらの基は、ポリマー中の主鎖、側鎖、末端基として存在することができる。ポリマー中の光架橋性基の量は、1~5, 000 mmol/kgであることが好ましく、5~5, 000 mmol/kgであることがさらに好ましい。このような基は、共重合モノマーや末端停止剤としてポリマー中に導入することができる。またエチレン性不飽和基を用いる場合には、ベンゾフェノン類、 α -ジケトン類、アシロイン類、アシロインエーテル類、ベンジルアルキルケタール類、アセトフェノン類、多核キノン類、チオキサントン類、アシルfosfin類などの光重合開始剤を加えておくことが好ましい。



ポリマーにイオン性基を導入する目的で下記の化合物も使用することができる。

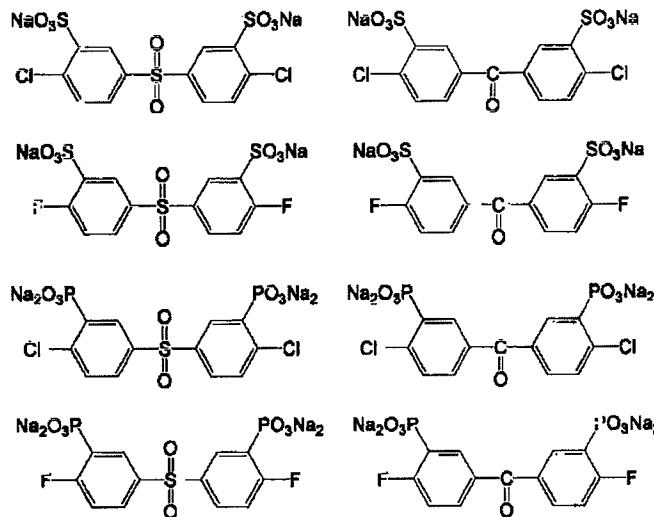
【0017】ポリマーの主鎖は公知の任意のポリマーを用いることができる。ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリスルフィド、ポリフェニレン、ポリベンズオキサゾール、ポリベンズイミダゾール、ポリベンズチアゾール、ポリケトン、ポリスルホンなどが耐久性に優れるため好ましい。中でも、合成の容易さからポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトンが好ましい。

【0018】ポリエーテルスルホンやポリエーテルケトンは、電子吸引性基を有する芳香族ジハロゲン化合物と、ビスフェノール化合物を縮合することで得られる。縮合反応は公知の方法で行なうことができる。例えば有機溶媒中で塩基の存在下加熱することで縮合できる。有機溶媒としては、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミド、スルホラン、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン性極性溶媒を挙げることができる。中でもN-メチル-2-ピロリドンが好ましい。塩基としては、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムなどが挙げられる。中でも炭酸カリウムが好ましい。ビスフェノール化合物と塩基との反応で生成する水は、トルエンやベンゼンとの共沸で除くことができる。共沸脱水は100~150°Cで行なうことが好ましい。脱水が完了後、縮合反応を行なうことができる。縮合反応は120~300°Cで行なうことができる。反応は窒素、アルゴンなど不活性ガス雰囲気下で行なうことが好ましい。反応終了後、溶液を水、アセトンなどポリマーが不溶の溶媒に投入することで再沈させることができる。再沈したポリマーは、公知の方法で精製することができる。

【0019】芳香族ジハロゲン化合物の例としては下記の化合物を挙げることができる。

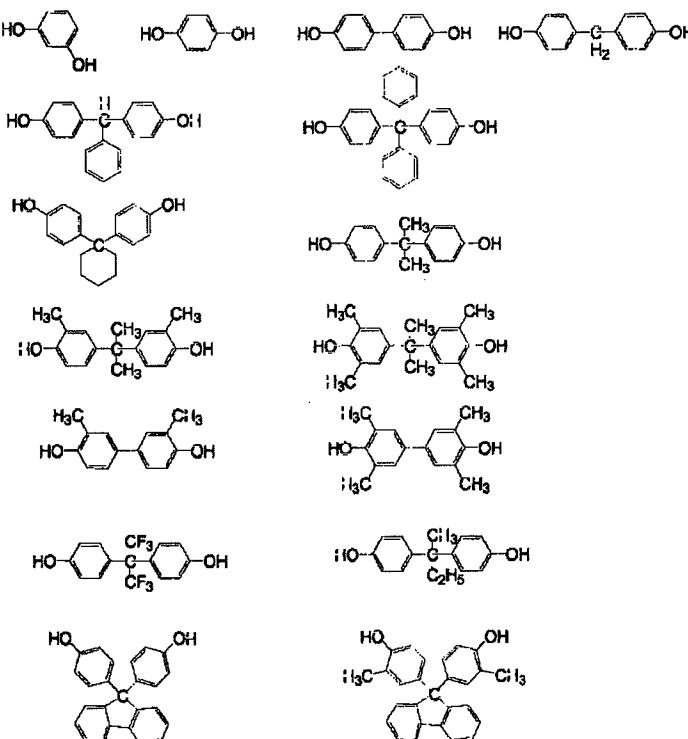
【化5】

【0020】
【化6】



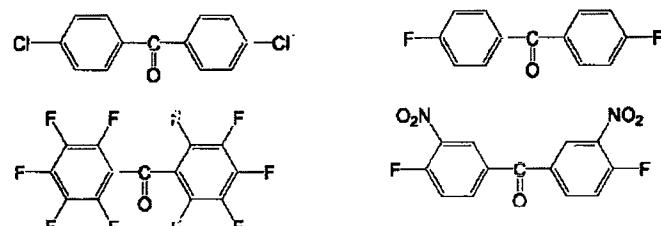
【0021】ビスフェノール化合物の例としては下記の化合物を挙げることができる。

【0022】
【化7】



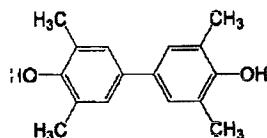
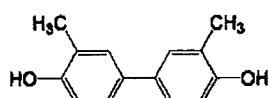
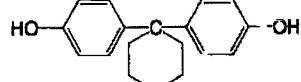
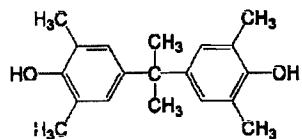
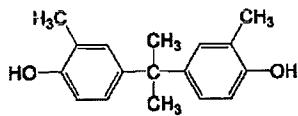
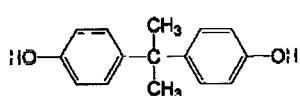
【0023】ポリマーにラジカル発生基を導入するためのモノマーとしては下記のような化合物を挙げることができる。

【化8】



【0024】ポリマーにラジカルと反応する基を導入するためのモノマーは下記のような化合物を挙げることができる。

【化9】

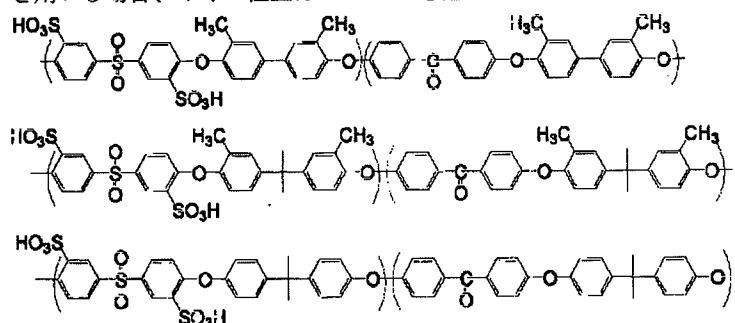


【0025】ラジカル発生基とラジカル反応性基は、同一のポリマーにあっても、別々のポリマーにあってもよい。それぞれの基を有する二種以上のポリマーを混合してもよいし、二つの基を有するポリマーを用いてもよい。二種以上のポリマーを用いる場合、イオン性基はい

ずれのポリマーにあってもよい。

【0026】本発明の光架橋性高分子固体電解質として好ましい例を下記に示すが、これらに限定されるものではない。

【化10】



【0027】本発明の光架橋性高分子固体電解質は、光照射によって架橋することができる。光照射は窒素、アルゴンなどの不活性ガス中で行なうことが好ましい。処理時の温度は、室温～250℃の範囲で行なうことができる。照射時間は、1秒～100時間の間で行なうことができる。光架橋をする際、本発明の高分子電解質そのものを熱処理して架橋体構造とすることもできるが、他の非架橋性ポリマーとの組成物としてから光架橋することもできる。その際、非架橋性ポリマーは本発明の架橋性ポリマーと同様にイオン性基を分子鎖中に含有するものでもイオン性基を含有しないものでもよい。非架橋性ポリマーの基本構造としては、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル類、ナイロン6、ナイロン6,6、ナイロン6,10、ナイロン12等のポリアミド類、ポリメチルメタクリレート、ポリメタクリル酸エステル類、ポリメチルアクリレート、ポリアクリル酸エステル類等のアクリレート系樹脂、ポリアクリル酸系樹脂、ポリメタクリル酸系樹脂、ジエン系ポリマーを含む各種ポリオレフィン、ポリウレタン系樹脂、酢酸セルロース、エチルセルロースなどのセルロース系樹脂、ポリアリレート、アラミド、ポリカーボネート、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンオキシド、ポ

リスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリベンズオキサゾール、ポリベンズチアゾール、ポリベンズイミダゾール、ポリアミドイミド等の芳香族系ポリマーなど、特に制限はない。

【0028】本発明の光架橋性高分子固体電解質は、膜に成形した後で架橋することで優れた高分子固体電解質膜となる。膜への成形は、キャスト、溶融成形など任意の方法で行なうことができるが、溶液からのキャストで作製することができる。溶媒には、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルホルムアミドなど非プロトン性極性溶媒を用いることができる。溶液の濃度は1～50wt%であることが好ましい。溶液をガラス板上に流延し、溶媒を乾燥させることで膜を得ることができる。膜の厚みは、1～500μmが好ましく、5～100μmがより好ましい。必要に応じて、シリカなどの無機化合物や、他のポリマーなどを混合してもよい。イオン性基が塩になっている場合には、膜に成形した後、酸で処理することで酸型に変換することができる。その場合、架橋反応が終了した後で酸交換することが好ましい。膜を光処理する場合には、収縮などを防ぐため、適当な治具に固定して加熱することが好ましい。この場合も、本発明の高

分子電解質そのものの成形体を熱処理して架橋体構造とすることもできるが、上述のような他の非架橋性ポリマーとの組成物成形体としてから光架橋することもできる。

【0029】本発明の高分子固体電解質膜は、水電解や燃料電池のプロトン交換膜として使用することができる。また、電極に触媒を接合する際のバインダーとして、本発明の高分子固体電解質を用いることができる。

【0030】

【実施例】以下、本発明について実施例を用いて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されることはない。各種測定は以下のようにして行なった。

【0031】(膜の厚み測定) 膜の厚みは膜厚計 (PE AKOCK DIGITAL GAUGE D-10/OZAKI MFG. CO., LTD) を用いて測定した。サンプル中のランダムな3点の厚みを測定し、それらを平均したものと膜の厚みとした。

【0032】(イオン伝導性測定) 自作測定用プローブ(ポリテトラフロロエチレン製)上で短冊状膜試料の表面に白金線(直径: 0.2 mm)を押しあて、80°C 95%RHの恒温・恒湿オープン((株)ナガノ科学機械製作所、LH-20-01)中に試料を保持し、白金線間の10 kHzにおける交流インピーダンスを SOLARTRON社 1250 FREQUENCY RESPONSE ANALYSERにより測定した。極間距離を変化させて測定し、極間距離と抵抗測定値をプロットした勾配から以下の式により膜と白金線間の接触抵抗をキャンセルした導電率を算出した。

$$\text{導電率} [\text{S/cm}] = 1 / \text{膜幅} [\text{cm}] \times \text{膜厚} [\text{cm}] \times \text{抵抗極間勾配} [\Omega/\text{cm}]$$

【0033】(ポリマー対数粘度) ポリマー濃度0.25 g/dlのN-メチル-2-ピロリドン溶液について、オストワルド粘度計を用いて30°Cで測定した。

【0034】(耐水性試験) ポリマー電解質膜50 mgを5 mlのイオン交換水と共にガラスアンプル中に封入した。アンプルは105°Cで3日間加熱した。冷却後アンプルを開封し、1 G2 のガラスフィルターで固形物を沪取した。フィルターは80°Cで一晩減圧乾燥し、沪過前後の重量から、固形分の重量を求め、重量減少率を求めた。

$$\text{重量減少率} [\%] = \frac{\text{残留物重量} [\text{mg}]}{50} \times 100$$

【0035】(イオン性基の定量) ポリマー電解質膜100 mgを0.01 NのNaOH水溶液50 mlに浸漬し、25°Cで一晩攪拌した。その後、0.05 NのHCl水溶液で中和滴定した。中和滴定には、平沼産業株式会社製電位差滴定装置COMTITE-980を用いた。イオン性基量は下記式で求められる。

$$\text{イオン性基含有量} [\text{meq/g}] = (10 - \text{滴定量} [\text{ml}]) / 2$$

【0036】(実施例1) 4, 4'-ジクロロジフェニ

ルスルホン-3, 3'-ジスルホン酸ソーダ3.930 g (8.0 mmol)、4, 4'-ジフルオロベンゾフェノン0.428 g (2.0 mmol)、2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)プロパン2.5634 g (10.0 mmol)、炭酸カリウム1.589 g (11.5 mmol)、N-メチル-2-ピロリドン20 ml、トルエン3 mlを窒素導入管、攪拌翼、ディーンスタークトラップ、温度計を取り付けた100 ml枝付きフラスコに入れ、オイルバス中で攪拌しつつ窒素気流下で加熱した。トルエンとの共沸による脱水を140°Cで行なった後、トルエンを全て留去した。その後200°Cに昇温し、15時間加熱した。その後、室温まで冷却した溶液を500 mlの純水に注ぎポリマーを再沈させた。沪過したポリマーは50°Cで減圧乾燥した。ポリマーの対数粘度は0.66 dl/gだった。得られたポリマー0.4 gを1.6 gのジメチルアセトアミドに溶解した溶液を、0.02 cmの厚みでガラス板上にキャストし、70°Cで3日間減圧乾燥した。ガラス板から膜を剥離した後、金属製の枠に固定し、窒素雰囲気下50°Cで紫外線ランプで1時間光照射した。その後、膜を80°Cの1 mol/L硫酸で1時間処理してスルホン酸基を酸型に変換し、さらに酸が検出できなくなるまで水で洗浄した。洗浄した膜は風乾したところ、厚み0.0038 cmの透明な膜が得られた。膜のイオン性基濃度は2.3 meq/gだった。耐水性試験での重量減少率は0%、イオン伝導性は0.34 S/cmであり、良好な耐久性とイオン伝導性を示した。

【0037】(比較例1) 4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン-3, 3'-ジスルホン酸ソーダ3.438 g (7.0 mmol)、4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン0.862 g (3.0 mmol)、ビフェノール1.862 g (10.0 mmol)、炭酸カリウム1.589 g (11.5 mmol)、N-メチル-2-ピロリドン17 ml、トルエン3 mlを窒素導入管、攪拌翼、ディーンスタークトラップ、温度計を取り付けた100 ml枝付きフラスコに入れ、オイルバス中で攪拌しつつ窒素気流下で加熱した。トルエンとの共沸による脱水を140°Cで行なった後、トルエンを全て留去した。その後200°Cに昇温し、15時間加熱した。室温まで冷却した溶液を500 mlの純水に注ぎポリマーを再沈させた。沪過したポリマーは50°Cで減圧乾燥した。ポリマーの対数粘度は0.75 dl/gだった。得られたポリマー0.4 gを1.6 gのジメチルアセトアミドに溶解した溶液を、0.02 cmの厚みでガラス板上にキャストし、70°Cで3日間減圧乾燥した。その後、膜を80°Cの1 mol/L硫酸で1時間処理してスルホン酸基を酸型に変換し、さらに酸が検出できなくなるまで水で洗浄した。洗浄した膜は風乾したところ、厚み0.0033 cmの透明な膜が得られた。膜のイオン性基濃度は2.3 meq/gだった。耐水性試験では膜

が溶解してしまい固体分が回収できなかった。イオン伝導性は0.28 S/cmだった。

【0038】(比較例2) 4, 4' -ジクロロジフェニルスルホン-3, 3' -ジスルホン酸ソーダ1.228 g (2.5 mmol)、4, 4' -ジクロロジフェニルスルホン2.154 g (7.5 mmol)、ビフェノール1.862 g (10.0 mmol)、炭酸カリウム1.589 g (11.5 mmol)、N-メチル-2-ピロリドン17 ml、トルエン3 mlを窒素導入管、攪拌翼、ディーンスタークラップ、温度計を取り付けた100 ml枝付きフラスコに入れ、オイルバス中で攪拌しつつ窒素気流下で加熱した。トルエンとの共沸による脱水を140°Cで行なった後、トルエンを全て留去した。その後200°Cに昇温し、15時間加熱した。室温まで冷却した溶液を500 mlの純水に注ぎポリマーを再沈させた。沪過したポリマーは50°Cで減圧乾燥し

た。ポリマーの対数粘度は0.84 dL/gだった。得られたポリマー0.4 gを1.6 gのジメチルアセトアミドに溶解した溶液を、0.02 cmの厚みでガラス板上にキャストし、70°Cで3日間減圧乾燥した。その後、膜を80°Cの1 mol/L硫酸で1時間処理してスルホン酸基を酸型に変換し、さらに酸が検出できなくなるまで水で洗浄した。洗浄した膜は風乾したところ、厚み0.0031 cmの透明な膜が得られた。膜のイオン性基濃度は0.8 meq/gだった。耐水性試験での重量減少率は0%だった。イオン伝導性は0.07 S/cmと低かった。

【0039】

【発明の効果】本発明の光架橋性高分子固体電解質により、耐久性とイオン伝導性に優れる高分子固体電解質膜を得ることができる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl. 7
H01M 8/10

識別記号

F I
H01M 8/10

(参考)

(72) 発明者 永原 重徳
滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内
(72) 発明者 濱本 史朗
滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内

(72) 発明者 中尾 淳子
滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
績株式会社総合研究所内
F ターム(参考) 4J005 AA24 BB01 BD06 BD07
4J030 BA05 BA09 BA42 BA49 BB29
BB37 BB66 BC08 BC16 BC18
BD03 BD10 BD22 BF09 BF13
BG06
5G301 CA30 CD01 CE01
5H026 AA06 CX05 EE18